

Micron 與 Broadcom 合作以解決 DRAM 時序問題，為網路用戶端提供改善的性能

協同解決曠日已久的 DDR3 tFAW 時序制約

愛達荷州博伊西，2013 年 12 月 18 日 (GLOBE NEWSWIRE) – 世界領先的先進半導體解決方案提供商之一 Micron Technology, Inc. (納斯達克代碼:MU) 今日宣佈其與 Broadcom 合作以為客戶開發業界首個針對固有的 DDR3 時序參數問題的解決方案，該時序參數稱為 tFAW，即 4 個啟動窗口的意思。

tFAW 指的是 DDR3 的一個時序參數，其會限制伺服器、記憶體和網路應用中的資料流量，可以使頻寬降低 15-35%。隨著每一代新 DRAM 的出現，存取解析度正在翻倍，使 tRDD 和 tFAW 等一些時序參數限制資料的流量。由於在任何給定的 tFAW 週期內不能發出多於 4 條的庫啟動命令，這些問題構成對高性能應用的挑戰。

“當出現連續的資料超載時，在網路提供者之間搜索增強的性能依然存在著挑戰”，IHS iSuppli 記憶體和 DRAM 高級首席分析師 Mike Howard 說。“能夠為高性能應用開啟頻寬的架構解決方案將有助於提高運行效率和網路整體性能”。

根據 Cisco(R) Visual Networking Index 的預測，從 2012 年至 2017 年，全球 IP 通信量的複合年增長率 (CAGR) 預計可達 23%。

為了滿足對頻寬勢不可擋的強烈需求，全球範圍內的服務提供者相競通過採用更高頻寬的連結以改造他們的網路。

通過 Broadcom 驗證的 Micron 解決方案處理大小為 2K 位元組頁的資料時，tFAW 值從 35 納秒降到 30 納秒，DDR3-2133 每秒運行能力提高了 18%。這種性能的提高對於複雜的資訊包處理功能，例如在服務供應商網路應用中使用的具高擴展性的 IPv4 和 IPv6 查詢能力，是特別重要的。在使用 Micron 的 DDR3 記憶體時，該 4 個啟動視窗解決方案使 Broadcom 的 BCM88030 200 Gb/s NPU 在網速性能上達到具極高擴展性的 L2、IPv4 和 IPv6 的查找能力。

“目前 OEM 在不斷地應對日益增長的容量、速度和資料形式方面的挑戰”，Micron 公司 DRAM 行銷副總裁 Robert Feurle 說。“我們非常高興與 Broadcom 一道工作，以驗證有助於為我們的互助客戶減輕流量壓力的解決方案”。

“Broadcom 致力於提供高頻寬容量和規模以滿足下一代網路的強烈需求”，Broadcom 電腦與連接產品行銷高級總監 Dan Harding 說。“通過與 Micron 的合作，我們將不斷努力，提供業界最具擴展性的 NPU 解決方案”。

供貨資訊

Micron 具有縮短 tFAW 時序功能的 2Gb 和 4Gb DDR3 現在開始批量供貨。

Micron 是網路市場忠誠的夥伴，擁有大批客戶和夥伴協作經驗，提供記憶體解決方案和能加速連接全世界的網路基礎設施建設的系統。欲瞭解更多資訊，請訪問 micron.com。

關於 Micron

Micron Technology, Inc., 是全球領先的先進半導體系統供應商。Micron 採用高性能記憶體技術的廣泛產品組合，包括 DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體等，是固態硬碟、模組、多晶片封裝及其他系統解決方案的基礎。Micron 憑藉其 35 年的技術領導地位，為世界最具創新性的計算、消費電子、企業級存儲、網路、移動產品、嵌入式和汽車應用提供記憶體解決方案。Micron 的普通股在納斯達克上市交易，代碼是 MU。欲瞭解有關美光科技公司的更多資訊，請訪問 www.micron.com。

聯繫方式: Zeno Group for Micron

Mary Ellen Ynes

maryellen.ynes@zenogroup.com

650-801-7954